(A) International Journal:


(B) Patents


[11] 簡昭欣、林慶宗、林育賢、張俊彥、雷添福，”利用矽酸鈣奈米微粒製備之非揮發性快閃記憶體”，中華民國專利，公告日期94年12月11日（發明第 I245375號）。

(C) International Conference:


(D) Local Conference:


[3] 游信強，吳承炎，謝韶徽，邱俊博，張元豪，林育賢，“功率MOS元件的漂移區的參數調整”，1st Conference on Applications of Innovation & Invention, Taichung, Taiwan, Nov. 24, 2011.

[4] 游信強，吳承炎，董秋溝，呂雅琳，王誠駿，林育賢，“UTBSOI鎳奈米點記憶體元件”，1st Conference on Applications of Innovation & Invention, Taichung, Taiwan, Nov. 24, 2011.


(E) Extra Publication

[1] 蕭郁蘋，林育賢，”電阻式記憶體於IC製程中的整合與發展”，電子月刊九月，2013。

[2] 林育賢，簡昭欣，雷添福，”奈米微晶粒在記憶體元件上的應用與發展”，電子月刊一月，2005。

[3] 林育賢、簡昭欣、周棟煥、洪錦石、雷添福，"高效能奈米微晶粒記憶體之製作"，奈米通訊第十二卷第一期，2005。